

SiCウェーハ用高性能研磨スラリー

NANOBIIX™

用途

- SiCウェーハ用、2液混合型研磨スラリー
Polishing slurry mixed of two-component for SiC wafers.

概要・特徴

- MnO₂砥粒により1工程でダメージフリーな加工が可能
MnO₂ abrasive enables your polishing w/o damage by one process.
- C面とSi面を同レートで加工可能
C and Si surfaces can be polished at the same rate.
- 装置洗浄/ウェハ洗浄が容易
Easy handling for equipment and wafer cleaning



A液 B液

	NANOBIIX™	一般品
砥粒	MnO ₂	Al ₂ O ₃ , SiO ₂
酸化剤	KMnO ₄	KMnO ₄
pH	8~9	2~4
研磨レート比		

	NANOBIIX™	一般品	
砥粒	MnO ₂	Al ₂ O ₃	SiO ₂
酸化剤	KMnO ₄	KMnO ₄	KMnO ₄
取り代	3μm	3μm	3μm
CMP後 Ra	0.14nm	0.13nm	0.13nm
CMP後			
H ₂ エッチング後			



三井金属

お問い合わせ
三井金属鉱業(株) 機能性粉体事業部

<https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/kinousei-funtai/>